



FIZIKA – MATEMATIKA FAKULTETI



F.I.SH.: Qurbanov Muzaffar Qadamboyevich
 LAVOZIM: Dotsent
 TEL: +99897 512 95 49
 E – mail: muzaffarqq@mail.ru
 TASHKILOT TEL: +99862 2246700
 TASHKILOT MANZILI: Urganch shahar Xamid Olimjon ko‘chasi 14. 220100

DARAJASI	oliy, 1999 yil, UrDU, fizika-matematika fakulteti
TAJIRIBA	1999 – 2001 – UrDU fizika kafedrası laboranti; 2001 – 2002 – Fizika kafedrasida UrDU tinglovchisi; 2002 – 2005 – UrDU fizika kafedrası aspiranti; 2005 – 2013 – UrDU Fizika kafedrası o‘qituvchisi; 2013 yildan hozirgi kungacha – UrDU fizika kafedrası dotsenti.
MUTAXASSISLIGI	Physical electronics.
O‘QITADIGAN FANLARI	Elektromagnetizm, radioelektronika.
TADQIQOT ISHI	Распыление кристалла LiF при облучении моно–и полиатомными ионами Ar^+ и SF_5^+
TADQIQOTLARI	1. Распыление кристалла LiF при облучении моно–и полиатомными ионами Ar^+ и SF_5^+ 2. Травление поверхности карбида кремния при бомбардировке молекулярными ионами SF_n^+ ($n=1\div5$) 3. Исследование распыления и топографии поверхности монокристалла LiF(100) при бомбардировке полиатомными ионами SF_n^+ 4. Исследование распыления и топографии поверхности монокристалла SiC при бомбардировке моно Ar^+ и полиатомными SF_5^+ ионами 5. Физическое и химически-стимулированное распыление 3C-SiC при бомбардировке ионами Ar^+ и полиатомными ионами SF_5^+ 6. Распыление кристалла LiF при облучении моно-и полиатомными ионами Ar^+ и SF_5^+ 7. Эмиссия атомарных и молекулярных ионов из LiF от энергии и скорости бомбардирующих ионов Ar^+ и SF_5^+ 8. Распыление монокристалла LiF при бомбардировке полиатомными ионами SF_n^+ ($n=1\div5$) 9. Эмиссия атомарных и молекулярных ионов из кристалла LiF при облучении моно Ar^+ и полиатомными SF_n^+ ($n=1\div5$) 10. Сверхвысоковакуумный вторично-ионный масс-спектрометр для изучения травления и структуры поверхности полупроводников и диэлектриков при облучении электронами, моно и полиатомными ионами 11. Распыление кремния и карбида кремния при бомбардировке моно Ar^+ и полиатомными ионами SF_5^+ 12. Исследование распыления и топографии поверхности монокристалла LiF(100) при бомбардировке полиатомными ионами SF_n^+ ($n=1\div5$)

	13. Распыление кремния и карбида кремния при бомбардировке моно Ar^+ и полиатомными ионами SF_5^+ 14. Распыление поверхности карбида кремния при бомбардировке молекулярными ионами SF_5^+ 15. Распыление поверхности кремния и карбида кремния при бомбардировке молекулярными ионами SF_n^+ ($n=1\div 5$) 16. Физическое и химическое распыление карбида кремния при бомбардировке моно Ar^+ и полиатомными ионами SF_5^+ 17. Анализ фторированной поверхности карбида кремния методом электронно–стимулированной десорбции 18. Исследование распыления и топографии поверхности монокристалла SiC при бомбардировке моно Ar^+ и полиатомными SF_5^+ ионами 19. Исследование распыления и топографии поверхности монокристалла LiF(100) при бомбардировке моно Ar^+ и полиатомными ионами SF_5^+ 20. Исследование стимулированного разрывом связей молекулярного распыления и травления поверхности пленки 3C-SiC при бомбардировке моно Ar^+ и полиатомными SF_5^+ ионами 21. Кинетика точечных дефектов и их агрегатов на поверхности пленки LiF/Si(111) 22. Изучение отрицательно-ионных кластеров SiC при бомбардировке ионами Cs^+
HOZIRGI TADQIQOTLARI	1. Распыления кристаллов при бомбардировке моно- и полиатомными ионам 2. Kinetics of aggregations F2, F3, X and colloid centers in thin film LiF/Si(111) at low temperature annealing 3. Исследование рассеяния ионов со ступенчатой поверхности двухкомпонентных монокристаллов 4. Температурный эффект атомарного и кластерного распыления SiC(100), GaN и LiF(100) при облучении ионами Cs^+ и SF_5^+ 5. Регистрация дефектов в спектрах ВИМС при отрицательно-ионном распылении кристаллов LiF 6. Молекулярное распыление из кристалла LiF при бомбардировке полиатомными ионами SF_n^+ ($n=1-5$) 7. Изучение массового состава положительно распыленных частиц из кристалла LiF при облучении ионами Ar^+ 8. Отрицательно-ионное распыление Al_2O_3 9. Распыления тонких плёнок, покрытой на поверхность Au(111) при бомбардировке ионами Ar^+ 10. Распыления тонких плёнок, покрытой на поверхность Au(111) при бомбардировке ионами Ar^+ 11. Mechanism of Aggregation Colloid Centers on Surface Ionic Crystals 12. Procedure for Determining Defects in Sputtered Clusters of Ionic Crystals 13. Изучения закономерности рассеяния ионов Ar^+ и Ne^+ с поверхности кластера кремния 14. Температурные зависимости распыления поверхности Si (111) при облучении ионами Cs 15. Влияние низкоэнергетических электронов на поверхность кристаллов оксида цинка 16. Электронно-спектрометрический контроль процесса очистки кремниевых пластин 17. Angular and energy distributions of low-energy argon ions at the scattering from $\text{Al}^{\text{III}}\text{B}^{\text{V}}$ semiconductor surface 18. Исследование малоугловое рассеяния ионов с поверхностью InP(001) 19. Изучение характерных траектории рассеянных ионов с поверхностью InP(001) при бомбардировке ионами Ar^+ и Ne^+ 20. Закономерности рассеяния ионов с поверхностью InP(001) при малых углах скольжениях 21. Рассеяния ионов с дефектной поверхностью InP(001) при малых углах скольжениях 22. LiF кристаллини якка ва кўпатомли ионлар таъсирида чанглатиш